

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第3区分
 【発行日】令和6年8月1日(2024.8.1)

【国際公開番号】WO2023/135844
 【出願番号】特願2023-573827(P2023-573827)

【国際特許分類】

H 0 3 H 3 / 0 8 (2 0 0 6 . 0 1)

H 0 3 H 9 / 2 5 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 3 H 3 / 0 8

H 0 3 H 9 / 2 5 C

10

【手続補正書】

【提出日】令和6年5月16日(2024.5.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

互いに対向する上面および下面を有し、前記下面に電極が設けられた圧電基板の前記下面側に第一の層を形成すること、

平坦化处理により、前記第一の層の表面のうねりを2nmを超え70nm以下とすること、および、

前記第一の層が形成された前記圧電基板の前記第一の層側に支持基板を接合すること、を含む、

複合基板の製造方法。

【請求項2】

30

前記接合時に、前記第一の層の接合面および前記支持基板側の接合面は活性化処理が施されている、請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】

プラズマ照射により前記活性化処理を行う、請求項2に記載の製造方法。

【請求項4】

前記接合後に、前記圧電基板の前記上面を研磨することをさらに含む、請求項1から3のいずれかに記載の製造方法。

【請求項5】

前記第一の層は酸化ケイ素を含む、請求項1に記載の製造方法。

40